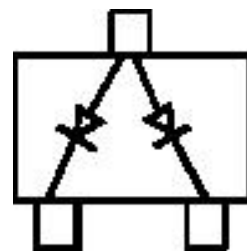


ISS181



SOT-23 内部结构

## SWITCHING DIODE 開關二極管

### FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^\circ\text{C})$	225	mW
Forward Current 正向電流	$I_F$	200	mA
Reverse Voltage 反向電壓	$V_R$	80	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	$T_J, T_{stg}$	-55to+150°C	

### DEVICE MARKING 打標

ISS181=A3

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

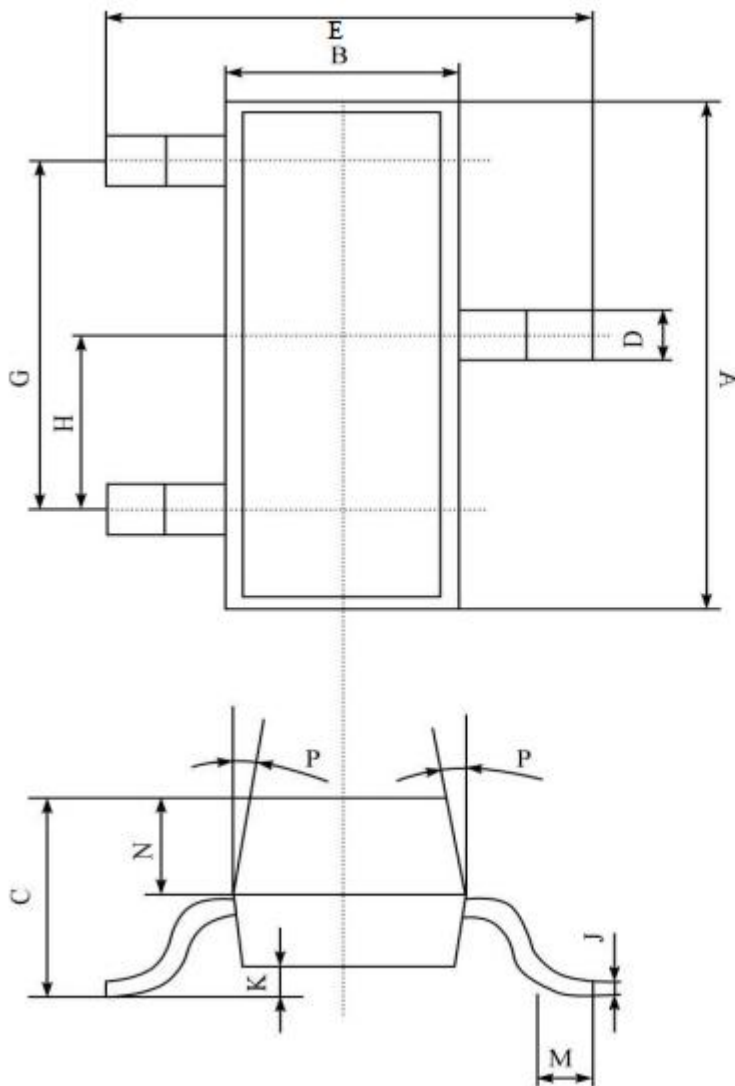
( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊说明, 溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ( $I_R=100\mu\text{A}$ )	$V_{(BR)}$	80	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 ( $V_R=80\text{V}$ )	$I_R$	—	0.5	$\mu\text{A}$
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=1\text{mA}$ $I_F=10\text{mA}$ $I_F=50\text{mA}$ $I_F=150\text{mA}$	$V_F$	—	715 855 1000 1250	mV
Diode Capacitance 二極體電容 ( $V_R=0\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$ )	$C_D$	—	1.5	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	$T_{rr}$	—	4	nS

1SS181

## ■ DIMENSION 外形封装尺寸

單位(UNIT): mm



代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>FOSAN\(富信\)](#)